

КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ ПАРА КРЕМНИЕВЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ со СВЕРХМАЛЫМ ПРЯМЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Транзисторы предназначены для применения в переключательных, импульсных схемах с низким напряжением насыщения и другой аппаратуре.

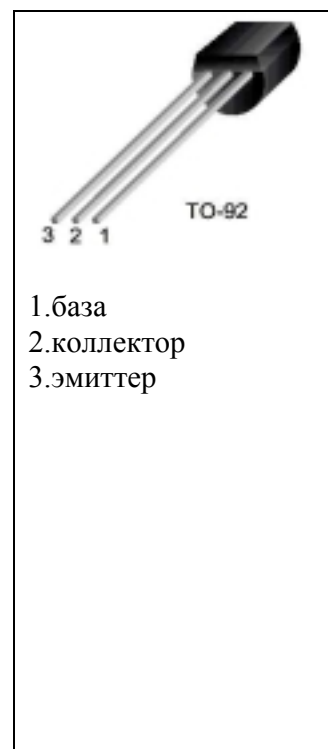
Транзисторы соответствуют АДБК 432140.943 ТУ

pnp
КТ529А
npn
КТ530А

Основные параметры

Параметр	Обозн.	КТ529 А КТ530 А	Единицы измерения
Обратный ток коллектора ($U_{cb}=80$ В)	I_c	1	МкА
Обратный ток эмиттера ($U_{eb}=4$ В)	I_e	1	МкА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_c/I_b=(300/10)$ мА)	U_{ce}	0.2	В
Статический коэффициент передачи тока ($U_{ce}=5$ В, $I_c=300$ мА)	h_{21e}	180	
Граничное напряжение ($I_e=10$ мА)		40	В
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{ce}=5$ В, $I_e=300$ мА, $f=100$ МГц)		1.5	

I_k max 1 А
 U_k max 60 В
 P max 0,5 W



Предельно-допустимые параметры

Параметр	Обозн.	КТ529 А КТ530 А	Единицы измерения
Максимальное постоянное напряжение коллектор- эмиттер	U_{ce} max	60	В
Максимальное постоянное напряжение эмиттер база	U_{eb} max	4	В
Максимально допустимый постоянный ток коллектора	I_c max	1	А
Рассеиваемая мощность	P max	0.5	Вт
Рабочая температура окружающей среды	T_{amb}	-60...+85	°С